PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-159523

(43) Date of publication of application: 13.06.2000

(51)Int.Cl.

CO1G 49/00 CO4B 35/38 H01F 1/34 H01F 37/00 // H01F 27/255

(21)Application number: 10-333544

(71)Applicant: HITACHI METALS LTD

(22)Date of filing:

25.11.1998

(72)Inventor: UCHIKAWA TERUO

KOYUHARA TOKUKAZU **NAKAJIMA TAKESHI**

(54) LOW LOSS FERRITE SINTERED COMPACT HAVING HIGHLY SATURATED MAGNETIC FLUX DENSITY AND CHOKE COIL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a low loss sintered compact having a high saturated magnetic flux density at a high temperature by composing main ingredients of a specified content of iron oxide, a specified content of zinc oxide and the rest of manganese oxide.

SOLUTION: This sintered compact has ≥450 T saturated magnetic flux density measured at 100° C and 100 A/m magnetic field, has ≤1,500 kW/m3 minimum core loss measured at 50 kHz and 150 mT and has ≤15% rate of change between the saturated magnetic flux density at 20° C and the one at 100° C. The sintered compact comprises 60-70 mol% iron oxide, 0-20 mol% zinc oxide (with proviso that the content is not zero) and the rest of manganese oxide as main ingredients and is obtained by calcinating the mixture at ≥1,150° C and ≤1% oxygen concentration in a holder for calcination.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-159523

(P2000-159523A)

(43)公開日 平成12年6月13日(2000.6.13)

式会社鳥取工場内

最終頁に続く

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ				テーマコード(参考)
C 0 1 G	49/00		C01G 4	9/00		В	4G002
C 0 4 B	35/38		H01F 3	7/00		N	4G018
H01F	1/34					Α	5 E O 4 1
	37/00		C04B 3	5/38		Z	
			H01F	1/34		В	
		審査請求	未請求 請求項	頁の数25 OI	. (全	7 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願平10-333544	(71)出顧人	000005083	式会社		
(22)出願日		平成10年11月25日(1998.11.25)		東京都港区	芝浦一丁	目2番	:1号
			(72)発明者	内川 晃夫			
				鳥取県鳥取	市南栄町	70番地	12号日立金属株
				式会社鳥取	工場内		
			(72)発明者	小湯原徳	t o		
				鳥取県鳥取	卡南柴町	70番地	12号日立金属株
				式会社鳥取	工場内		
			(72)発明者	中島剛			
				鳥取県鳥取	市南柴町	70番地	12号日立金属株

(54) 【発明の名称】 高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体およびチョークコイル

(57)【要約】

【課題】 電子機器の高集積化および大電流化における 発熱の問題に対して、信頼性の高いフェライトコアおよ びこれを用いたチョークコイルを提供する。

【解決手段】 酸化鉄の含有量が60~75mol%、、酸化亜鉛の含有量が0~20mol%(ただし、0を含まず)および残部が酸化マンガンから成り、100℃での飽和磁束密度が450mT以上であり、かつ50kHz、150mTでのコアロスの最小値が1500kW/m³以下であるフェライト焼結体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 測定磁界が1000A/mにおいて、100℃での飽和磁束密度が450mT以上であり、かつ測定条件が50kHz、150mTにおいて、コアロスの最小値が1500kW/m³以下であることを特徴とする高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

【請求項2】 主成分として、酸化鉄の含有量が60~75mo1%、酸化亜鉛の含有量が0~20mo1% (ただし、0を含まず)および残部が酸化マンガンから成ることを特徴とする請求項1記載の高飽和磁束密度低 10損失フェライト焼結体。

【請求項3】 焼成温度が1150℃以上であり、焼成時の保持部の酸素濃度が1%以下の条件で焼成されたことを特徴とする請求項2記載の高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

【請求項4】 測定磁界が1000A/mにおいて、20℃での飽和磁束密度に対する100℃での飽和磁束密度の変化率が15%以下であり、かつ測定条件が50kHz、150mTにおいて、コアロスの最小値が1500kW/m³以下であることを特徴とする高飽和磁束密20度低損失フェライト焼結体。

【請求項5】 主成分として、酸化鉄の含有量が60~75mol%、酸化亜鉛の含有量が0~20mol% (ただし、0を含まず) および残部が酸化マンガンから成ることを特徴とする請求項4記載の高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

【請求項6】 焼成温度が1150℃以上であり、焼成時の保持部の酸素濃度が1%以下の条件で焼成されたことを特徴とする請求項5記載の高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

【請求項7】 測定磁界が4000A/mにおいて、100℃での飽和磁束密度が480mT以上であり、かつ測定条件が50kHz、150mTにおいて、コアロスの最小値が1500kW/m³以下であることを特徴とする高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

【請求項8】 主成分が、酸化鉄の含有量が60~75 mo1%、酸化亜鉛の含有量が0~20mo1% (ただし、0を含まず) および残部が酸化マンガンから成ることを特徴とする請求項7記載の高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

【請求項9】 焼成温度が1150℃以上であり、焼成時の保持部の酸素濃度が1%以下の条件で焼成されたことを特徴とする請求項8記載の高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

【請求項10】 測定磁界が4000A/mにおいて、 20℃での飽和磁東密度に対する100℃での飽和磁束 密度の変化率が20%以下であり、かつ測定条件が50 kHz、150mTにおいて、コアロスの最小値が15 00kW/m³ 以下であることを特徴とする高飽和磁束 密度低損失フェライト焼結体。 【請求項11】 主成分として、酸化鉄の含有量が60~75mol%、酸化亜鉛の含有量が0~20mol%(ただし、0を含まず)および残部が酸化マンガンから成ることを特徴とする請求項10記載の高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

【請求項12】 焼成温度が1150℃以上であり、焼成時の保持部の酸素濃度が1%以下の条件で焼成されたことを特徴とする請求項11記載の高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

【請求項13】 測定磁界が1000A/mにおいて、 100℃での飽和磁束密度が450mT以上であり、か つ測定条件が100kHz、200mTにおいて、コア ロスの最小値が6000kW/m³以下であることを特 徴とする高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

【請求項14】 主成分として、酸化鉄の含有量が60~75mol%、酸化亜鉛の含有量が0~20mol%(ただし、0を含まず)および残部が酸化マンガンから成ることを特徴とする請求項13記載の高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

【請求項15】 焼成温度が1150℃以上であり、焼成時の保持部の酸素濃度が1%以下の条件で焼成されたことを特徴とする請求項14記載の高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

【請求項16】 測定磁界が1000A/mにおいて、20℃での飽和磁束密度に対する100℃での飽和磁束密度の変化率が15%以下であり、かつ測定条件が100kHz、200mTにおいて、コアロスの最小値が6000kW/m³以下であることを特徴とする高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

30 【請求項17】 主成分として、酸化鉄の含有量が60~75mol%、酸化亜鉛の含有量が0~20mol% (ただし、0を含まず)および残部が酸化マンガンから成ることを特徴とする請求項16記載の高飽和磁束密度 低損失フェライト焼結体。

【請求項18】 焼成温度が1150℃以上であり、焼成時の保持部の酸素濃度が1%以下の条件で焼成されたことを特徴とする請求項17記載の高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

【請求項19】 測定磁界が4000A/mにおいて、 40 100℃での飽和磁束密度が480mT以上であり、か つ測定条件が100kHz、200mTにおいて、コア ロスの最小値が6000kW/m³以下であることを特 徴とする高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

【請求項20】 主成分として、酸化鉄の含有量が60~75mol%、酸化亜鉛の含有量が0~20mol%(ただし、0を含まず)および残部が酸化マンガンから成ることを特徴とする請求項19記載の高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体。

【請求項21】 焼成温度が1150℃以上であり、焼 50 成時の保持部の酸素濃度が1%以下の条件で焼成された

1

ことを特徴とする請求項20記載の高飽和磁束密度低損 失フェライト焼結体。

【請求項22】 測定磁界が4000A/mにおいて、 20℃での飽和磁束密度に対する100℃での飽和磁束 密度の変化率が20%以下であり、かつ測定条件が10 OkHz、200mTにおいて、コアロスの最小値が6 000kW/m³以下であることを特徴とする高飽和磁 東密度低損失フェライト焼結体。

【請求項23】 主成分として、酸化鉄の含有量が60 ~75mo1%、酸化亜鉛の含有量が0~20mo1% 10 (ただし、0を含まず) および残部が酸化マンガンから 成ることを特徴とする請求項22記載高飽和磁束密度低 損失フェライト焼結体。

【請求項24】 焼成温度が1150℃以上であり、焼 成時の保持部の酸素濃度が1%以下の条件で焼成された ことを特徴とする請求項23記載の高飽和磁束密度低損 失フェライト焼結体。

【請求項25】 請求項1から24のいずれかの高飽和 磁束密度低損失フェライト焼結体を用いて作製したこと を特徴とするチョークコイル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、100℃程度の高 温度において高い飽和磁束密度と低損失を有するフェラ イト焼結体およびこれを用いたチョークコイルに関す る。

[0002]

【従来の技術】近年、各種電子機器はLSIの微細化、 高集積化および高周波化により、多機能化、小型軽量化 がいっそう加速されている。このように各種部品の集積 30 度が上がり高速化、高性能化が進むことにより、電力を 供給する電源ラインにも高パワーが要求されるととも に、回路の高効率化の要求もいっそう高くなっている。

【0003】例えば、ノート型パソコンを例にあげる と、部品の集積度があがってくることや、CPUからの 発熱が大きくなることなどから、回路周辺の熱のコント ロールが重要な課題となっている。

【0004】また、多機能、高品位の流れとして、CP Uの高速化、すなわち処理能力の向上、記憶装置の大容 量化と高スピード化などにより、電力を供給するDC/ 40 DCコンバータの大電流化が進み、回路の効率が悪くな るという問題もある。つまり、高性能なCPUを用いた ノート型パソコンのDC/DCコンバータには、高温に おいても所定の性能を保つことと、高効率であることが 重要であると言える。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記の理由により、ノ ート型パソコン等のDC/DCコンバータに用いられる チョークコイルにも、高温において所定の性能を保ち、

いる。

【0006】これらチョークコイルのコアに使用される 磁性材料としては、金属系磁性材料とフェライトの 2種 類があり、フェライトはさらに、Ni系とMn系に分け られる。金属系磁性材料は、フェライトに比べて飽和磁 束密度が高く、このため大きな電流を流しても磁気飽和 しにくいというメリットがあるが、一般的に値段が髙 く、また高周波になると使用できないと言う問題があ る。この点、フェライトに関しては、髙周波でも使用可 能であり、また価格も安いというメリットがある。なか でもフェライトにおいては、一般的にNi系フェライト に比べてMn系フェライトの方が飽和磁束密度が高く、 損失が小さいためチョークコイルに適している。

4

【0007】しかしながら、従来のMn系フェライトに おいては、20℃程度の飽和磁束密度は高いものの、高 温になると飽和磁束密度が低くなり、通常、100℃で の飽和磁束密度は20℃での飽和磁束密度に比べて20 ~25%程度低下していた。このため、DC/DCコン バータ等のトランスにMn系のフェライトを使用した場 20 合、CPU等の発熱によりフェライトコアの温度が上昇 すると、飽和磁束密度が低下してしまうという問題があ った。

【0008】本発明は、上記の事を鑑みて、100℃程 度の高温度において高い飽和磁束密度を有し、しかも低 損失であるェライト焼結体を提供すること、又これを用 いたチョークコイルを提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、測定磁界が1 000A/mにおいて100℃での飽和磁束密度が45 0mT以上であり、かつ測定条件が50kHz、150 mTにおいてコアロスの最小値が1500kW/m°以 下であることを特徴とする高飽和磁束密度低損失フェラ イト焼結体である。

【0010】また本発明は、測定磁界が1000A/m において20℃での飽和磁束密度に対する100℃での 飽和磁束密度の変化率が15%以下であり、かつ測定条 件が50kHz、150mTにおいてコアロスの最小値 が1500kW/m³以下であることを特徴とする高飽 和磁束密度低損失フェライト焼結体である。

【0011】また本発明は、測定磁界が4000A/m において100℃での飽和磁束密度が480mT以上で あり、かつ測定条件が50kHz、150mTにおいて コアロスの最小値が1500kW/m°以下であること を特徴とする高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体で

【0012】また本発明は、測定磁界が4000A/m において20℃での飽和磁束密度に対する100℃での 飽和磁束密度の変化率が20%以下であり、かつ測定条 件が50kHz、150mTにおいてコアロスの最小値 かつ発熱を抑えるために損失の小さいことが要求されて 50 が1500kW/m³以下であることを特徴とする高飽 5

和磁束密度低損失フェライト焼結体である。

【0013】また本発明は、測定磁界が1000A/mにおいて100℃での飽和磁束密度が450mT以上であり、かつ測定条件が100kHz、200mTにおいてコアロスの最小値が6000kW/m³以下であることを特徴とする高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体である。

【0014】また本発明は、測定磁界が1000A/mにおいて20℃での飽和磁束密度に対する100℃での飽和磁束密度の変化率が15%以下であり、かつ測定条件が100kHz、200mTにおいてコアロスの最小値が6000kW/m³以下であることを特徴とする高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体である。

【0015】また本発明は、測定磁界が4000A/mにおいて100℃での飽和磁束密度が480mT以上であり、かつ測定条件が100kHz、200mTにおいてコアロスの最小値が6000kW/m³以下であることを特徴とする高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体である。

【0016】また本発明は、測定磁界が4000A/m 20において20℃での飽和磁束密度に対する100℃での飽和磁束密度の変化率が20%以下であり、かつ測定条件が100kHz、200mTにおいてコアロスの最小値が6000kW/m³以下であることを特徴とする高飽和磁束密度低損失フェライト焼結体である。

【0017】また本発明の高温度高飽和磁束密度フェライト焼結体は、主成分として酸化鉄の含有量が60~75mol%、酸化亜鉛の含有量が0~20mol%(ただし、0を含まず)および残部が酸化マンガンから成るMnZn系フェライト焼結体であることが好ましい。

【0018】また本発明のMnZn系フェライト焼結体は、焼成温度が1150℃以上であり、焼成時の保持部の酸素濃度が1%以下の焼成条件にて焼成されることが好ましい。なお、仮焼成を窒素中で行うと、飽和磁束密度はさらに向上する。このため、仮焼成を窒素中で行うことが好ましい。

【0019】また本発明は、上記の特徴を有するフェライト焼結体を用いてチョークコイルを作製することにより、高温において、所望の性能を有するチョークコイルを得ることができる。

[0020]

【発明の実施の形態】従来のMn系フェライトにおいて、高飽和磁束密度を有するもので、20℃における飽和磁束密度が500mTを越えるものがある。しかし、100℃となると、飽和磁束密度は400mT程度に減少し、100℃で高い飽和磁束密度を有するものは無かった。また、20℃と100℃の飽和磁束密度の変化率をみても、少ないもので20%程度劣化していた。

【0021】本発明は、高温度で高飽和磁束密度であり、かつ低損失のフェライト焼結体を得ることを目的と 50

し、主成分組成の選定、仮焼成雰囲気の制御、焼成条件の制御の検討を種々試みた。その結果、高温度で高飽和磁束密度であり、且つ低損失のフェライト焼結体を得ることが出来ることを見いだした。

6

【0022】つまり、本発明のフェライト焼結体は、以下に示す少なくともいずれかの高温高飽和磁束密度特性を有することを特徴としている。

- (1) 測定磁界が1000A/mにおいて、100℃での飽和磁束密度が450mT以上である。好ましくは、470mT以上、さらに好ましくは500mT以上である。
- (2) 測定磁界が1000A/mにおいて、20℃での 飽和磁束密度に対する100℃での飽和磁束密度の変化 率が15%以下である。好ましくは、10%以下、さら に好ましくは、5%以下である。
- (3) 測定磁界が4000A/mにおいて、100℃での飽和磁東密度が480mT以上である。好ましくは、500mT以上、さらに好ましくは520mT以上である。
- (4) 測定磁界が4000A/mにおいて、20℃での 飽和磁束密度に対する100℃での飽和磁束密度の変化 率が20%以下である。好ましくは、15%以下、さら に好ましくは、10%以下である。

【0023】さらに本発明のフェライト焼結体は、上記した高温高飽和磁束密度特性を有したままで、以下の少なくともいずれかの低損失特性をあわせもつことを特徴としている。

- (1) 測定条件が50kHz、150mTにおいて、コアロスの最小値が $1500kW/m^3$ 以下である。好ましくは、 $1000kW/m^3$ 以下であり、さらに好ましくは、 $500kW/m^3$ 以下である。
- (2) 測定条件が100kHz、200mTにおいて、コアロスの最小値が $6000kW/m^3$ 以下である。好ましくは、 $4000kW/m^3$ 以下であり、さらに好ましくは、 $3000kW/m^3$ 以下である。

【0024】測定磁界が1000A/mあるいは4000A/mにおいて、100℃での飽和磁束密度が450mT未満あるいは480mT未満の場合、大きな電流を流すとフェライトコアの磁束密度が飽和に達して変化しなくなるため、チョークコイルとしての機能が果たせなくなる。このため、大電流を流すことができない。

【0025】また、測定磁界が1000A/mあるいは4000A/mにおいて、20℃での飽和磁束密度に対する100℃での飽和磁束密度の変化率が20%以上の場合、上記の理由により、大電流を流すことができない。

【0026】また、測定条件が50kHz、150mT あるいは100kHz、200mTにおいて、コアロス の最小値が $1500kW/m^3$ あるいは $6000kW/m^3$ を越える場合、チョークコイルの温度が上昇し、所

定の特性が得られなくなる。

【0027】本発明のフェライトの主成分組成として は、酸化鉄の含有量が60~75mol%、酸化亜鉛の 含有量が0~20mo1% (ただし、0を含まず) およ び残部が酸化マンガンであることが好適である。

【0028】酸化鉄の含有量が60mol%未満である と、高温における飽和磁束密度が低下し、飽和磁束密度 の変化率が大きくなってしまう。さらに、コアロスの最 小値を示す温度が20℃以下となり、コアの温度が20 ℃を越えると熱暴走を起こす危険がある。また、酸化鉄 10 の含有量が 7 5 m o 1 %を越えると、焼結密度が低くな り、結果として、透磁率および飽和磁束密度が低くなっ てしまい、コアロスも増大する。よって、酸化鉄の含有 量は60~75mo1%が良い。好ましくは、65~7 5 m o 1%である。

【0029】また、酸化亜鉛の含有量が20m01%を 越えても、飽和磁束密度の変化率が大きくなってしま う。よって、酸化亜鉛の含有量は0~20mol%(た だし、0を含まず)が良い。

【0030】また、本発明のフェライトの製造方法とし 20 ては、焼成温度が1150℃以上であり、焼成時の保持 部の酸素濃度が1%以下の条件で焼成することが望まし い。なお、仮焼成を窒素中で行うと、さらに飽和磁束密 度が向上する。このため、仮焼成を窒素中で行うことが 好ましい。

【0031】焼成温度が1150℃未満であると、焼結 密度が低くなり、結果として透磁率および飽和磁束密度 が低くなってしまい、コアロスも増大する。また、焼成 時の保持部の酸素濃度が1%を越えても、焼結密度が低 くなり、結果として透磁率および飽和磁束密度が低くな 30 ってしまい、コアロスも増大する。

*【0032】また、窒素中で仮焼成を行うと、空気中で 行う場合に比べて組成分布が均一化され、特性が向上す

【0033】なお、主成分の一部をLi、Mg、Ti、 Co、Ni、Cu、Snで、それぞれ5mol%以下置 換しても良い。また添加物としては、A1、Si、K、 Ca, V, Y, Zr, Nb, Mo, Te, Hf, Ta, W、Biの酸化物、あるいはこれらの化合物を、それぞ れ0.2wt%以下含んでも良い。

【0034】本発明に係る実施例を以下に詳細に説明す る。

実施例1

酸化鉄、酸化亜鉛および四三酸化マンガンを各々所定 量、秤量し、これに水および分散剤を加えて媒体撹拌ミ ルにて混合し、乾燥後、窒素中、910℃にて1.5時 間仮焼成した。これに、添加物として、CaCO₃ 7 0.0 ppm, SiO_2 6.0 ppm, Nb_2O_5 2.5OppmおよびTa2Os 5Oppmを加え、さらに 水および分散剤を加えて媒体撹拌ミルにて混合および粉 砕を行い、スラリーを作製した。このようにして作製し たスラリーに、バインダーを所定量加えて撹拌し、乾燥 した後、乾式のプレス成形によりリング状のコアを作製 した。これを、酸素濃度1%、1300℃にて5時間焼 成し、得られたフェライト焼結体の焼結密度、初透磁 率、20℃および100℃の飽和磁束密度および飽和磁 東密度の変化率、コアロスを測定した。なお、飽和磁束 密度の変化率は、(20℃の飽和磁束密度-100℃の 飽和磁束密度) / 20℃の飽和磁束密度×100 [%] の式にて計算した。結果を表1に示す。

[0035]

【表1】

₩.			烧结密度	初透磁率							コアロ	億考		
	Fe ₂ O ₂	ZnO	MnO	(bus/m³)	et 10kHz	et 1000(A/m)		at 4000 (A/m)			50MHz	I COMH2		
L			L	L		20℃	100°C	变化率	20℃	100°C	变化率	150mT	200mT	
1	.30	15	_5	4780	50	455	456	0	565	605	198	2606(140°C)	B760(140°C)	比較例
2	80	10	10	4760	55	475	470	1.1	580	522	19.2	2137(140°C)	7205(140°C)	И
3	80	5	15	4140	50	465	450	32	567	500	118	2382(140°C)	7787(140°C)	и
4	70	15	15	4820	220	504	470	5.7	615	520	15.4	919(140°C)	3207(140°C)	本発明
5	70	10	20	4180	250	485	459	37	593	519	125	677(140°C)	281B(140°C)	н
6	.70	_ 5	25	4750	300	478	483	_ 3.1	583	614	11.8	805(80°C)	2938(80°C)	"
7	60	_15_	25	4910	1300	534	456	14.8	820	508	18.4	326(20°C)	1431(20°C)	"
8	60	10	30	4900	780	645	466	145	620	517	166	451(20°C)	1810(20°C)	"
9	60	5	35	4950	49D	55D	470	14.5	520	521	16	727(20°C)	2684(20°C)	"
01	55	10	35	4950	3000	540	430	204	820	477	231	98(0°C)	500(0°C)	比較例
ш	-60	25	15	4950	2200	500	410	18	610	455	25.4	[71(-20°C)	950X-20°C)	"

【0036】表1から分かるように、本発明の実施例 は、100℃における飽和磁束密度が高く、飽和磁束密 40 度の変化率も小さいことが分かる。しかも、コアロスの 値も小さく、低損失であることがわかる。

【0037】これに対し、酸化鉄の含有量が60mol %未満になると、100℃における飽和磁束密度が低下 する。しかも、飽和磁東密度の変化率も20%を越えて しまう。また、酸化鉄の含有量が80mo1%以上にな ると、初透磁率および飽和磁束密度が低下し、コアロス も増大することが分かる。また、酸化亜鉛の含有量が2 0 m o 1 %を越えても、100℃における飽和磁束密度 度の変化率が20%を越えてしまう。

【0038】実施例2

酸化鉄を70m01%、酸化亜鉛を10m01%および 四三酸化マンガンを20mo1%秤量し、これに水およ び分散剤を加えて媒体撹拌ミルにて混合し、乾燥後、所 定の雰囲気で、910℃にて1.5時間仮焼成した。こ れに、添加物として、CaCOs 700ppm、Si O2 100ppm、およびTa2O5300ppmを 加え、さらに水および分散剤を加えて媒体撹拌ミルにて 混合および粉砕を行い、スラリーを作製した。このよう にして作製したスラリーに、バインダーを所定量加えて が低下する。また、4000A/mにおいて飽和磁束密 50 撹拌し、乾燥した後、乾式のプレス成形によりリング状

のコアを作製した。これを、所定の酸素濃度および温度 にて5時間焼成し、得られたフェライト焼結体の焼結密 度、初透磁率、20℃および100℃の飽和磁束密度お よび飽和磁束密度の変化率、コアロスを測定した。な

*-100℃の飽和磁束密度) / 20℃の飽和磁束密度× 100 「%」の式にて計算した。結果を表2に示す。 [0039] 【表2】

お、飽和磁束密度の変化率は、(20℃の飽和磁束密度*

No	仮焼成	本	挽成	烧結密度	初遊磁率	與和磁束密度[mT]						בסקב.	備考	
	PO ₂	PO ₂	涅度	(kg/m ⁶)	at IOkHz	at 1000[A/r		m)	at 4000 [A/		m] 60kHz		100kHz	
	[%]	[%]	["[]			20℃	100°C	至化平	20℃	100°C	党化率	150mT	200mT	
1	京素中	0.01	1300	4820	350	512	502	2	611	538	11.9	474(100°C)	2700(100°C)	本発明
2	u	01	"	4870	47D	500	48D	4	600	525	125	680(100°C)	2710(1D0°C)	a
8	0	_	"_	4780	250	488	468	3.7	693	519	12,6	877(140°C)	2818(140°C)	#
4	0	10	U	4710	200	456	438	3.9	561	480	127	1450(140°C)	5330(140°C)	比較例
5	0	意意中	1350	4880	290	470	470	0	572	511	107	1142(12D°C)	5874(1D0°C)	本発明
6	u	#	1300	4830	360	510	500	2	610	535	123	589(120°C)	3119(120°C)	11
7	u	"	1250	4870	490	_525	503	42	625	540	13.6	437(120°C)	1845(100°C)	0
8	- 11	"	1200	4870	300	506	483	4.4	603	529	123	624(120°C)	4211(120°C)	- //
9	u	"	1150	4780	340	488	460	5.7	590	520	119	B47(100°C)	3470(100°C)	
10	- 11	п	1100	4700	260	405	390	3.7	513	440	142	970(100°C)	4990(100°C)	比較例
11	空気中	. "	1350	4820	270	.458	456	0.7	567	503	11.3	886(140°C)	4410(120°C)	本発明
12	"	n	1300	4810	38D	498	485	2.5	598	526	12	509(120°C)	4790(120°C)	n
13	"		1250	4730	540	505	475	5.9	600	524	127	455(120°C)	1920(100°C)	a
14	"	"	1200	4730	260	465	450	32	572	509	11.2	860(120°C)	4350(100°C)	"

【0040】表2からわかるように、本発明の実施例 は、100℃における飽和磁束密度が高く、コアロスが 小さいことが分かる。

【0041】これに対し、焼成時の保持部の酸素濃度が 1%を越えたり、あるいは焼成温度が1150℃未満に ロスも増大してしまう。

【0042】また仮焼成を窒素中で行うと、空気中で行 う場合に比べて焼結密度が向上し、結果として20℃お よび100℃における飽和磁束密度が向上することが分 かる。

【0043】実施例3

実施例2において、表2のNo.6の原料を用いて、チ ョークコイルを作製し、直流重畳特性を測定した。また 比較例として、酸化鉄を55mo1%、酸化亜鉛を10 〇換算) の組成を持つ同形状のフェライト焼結体を用い てチョークコイルを作製し、直流重畳特性を測定した。 結果を図1に示す。図1は、100℃における直流重畳 特性において、Lの変化率を示したものである。

【0044】図1からわかるように、本発明の実施例 は、従来材である比較例に比べて、直流重畳特性が良好 で、大きな電流を流せることが分かる。また、本発明の 実施例は、従来材である比較例に比べて、高温における 直流重畳特性の劣化も少なく、発熱に対して安定した特※

※性を発揮できることが分かる。

【0045】上記のとおり、本発明に係るフェライト焼 結体およびチョークコイルは、100℃における飽和磁 東密度が高く、また20℃の飽和磁東密度に対する10 0℃の飽和磁束密度の変化率が、従来のフェライト焼結 なると、100℃における飽和磁束密度が低下し、コア 20 体に比べて小さく、かつ損失も小さいため、電子機器の 高集積化および大電流化における発熱の問題に対して、 安定した特性を発揮することができ、電子機器の小型化 に対して、非常に有効な電子部品である。

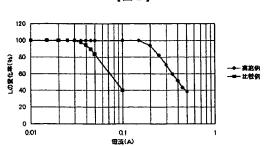
[0046]

【発明の効果】本発明によれば、100℃における飽和 磁束密度が高く、また20℃の飽和磁束密度に対する1 00℃の飽和磁束密度の変化率が小さく、かつ損失の小 さいフェライト焼結体を得ることが出来る。これにより ノート型パソコンなどのDC/DCコンバータに使用さ mol%および四三酸化マンガンを35mol%(Mn 30 れるチョークコイルにおいて、フェライトコアの高温時 における飽和磁束密度などの特性の劣化を抑制すること ができ、しかも高温時の飽和磁束密度が高く、かつ損失 が小さいため、電子機器の高集積化および大電流化にお ける発熱の問題に対して、安定した特性を発揮すること ができ、電子機器の小型化に非常に有用である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る実施例および比較例の直流重畳特 性を表す図である。

【図1】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. [†]
// H O 1 F 27/255

識別記号

FI HO1F 27/24 テーマコード(参考)

D

F ターム(参考) 4G002 AA06 AA07 AA12 AB01 AE02 4G018 AA08 AA18 AA19 AA21 AA25 AA31 AC05 AC08 AC14 AC16 5E041 AB02 BD01 CA02 HB03 NN13 NN15 NN17 NN18